解 説

シリカ複合分離膜の細孔径微細制御

野村 幹弘

芝浦工業大学 工学部 応用化学科

(受取日: 2022 年 8月 23日, 受理日: 2022 年 9月 27日)

Detail Control of Pore Sizes for Silica Hybrid Separation Membranes

Mikihiro Nomura

Sibaura Institute of Technology, Department of Applied Chemistry

(Received Aug. 23, 2022; Accepted Sep. 27, 2022)

Detail pore size control for silica composite separation membrane was performed. Silica composite membranes were deposited on porous ceramic substrates by chemical vapor deposition. An organic group is introduced into the silica structure by introducing an organic group into the silica precursor used during membrane preparation. A membrane with a pore diameter of 0.37 nm without organic groups was obtained, which selectively permeated hydrogen. The pore diameters increased to 0.40 nm when propyl groups were introduced as an organic group. Furthermore, the hydrogen permeance also increased to 3.7 times. This vapor deposition phenomenon was investigated by investigating the thermal decomposition behavior of organic groups on hydrated silica powder. The decomposition/deposition behavior changes at low, medium, and high temperatures. Decomposition of organic groups by ozone was observed at a low temperature of about 200 °C. On the other hand, at medium temperatures of about 250 °C, the decomposition of the reaction aid, ozone, progressed, and the decomposition of the organic groups is limited. At high temperatures above 400 °C, thermal decomposition of the organic groups is dominant, and the amount of organic groups in the separation layer is decreasing. Keywords: silica membranes, pore size control, decomposition of organic groups

1. はじめに

2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、二酸 化炭素回収技術や効率的なグリーン水素製造法の開発が注 目されている。そのため、従来用いられている高分子分離 膜と比較して剛直な性質をもち、高い選択性と高温でのア プリケーションが期待できる無機分離膜の開発が進められ ている。1-3) ここでは、水素分離や二酸化炭素分離に向けた シリカ複合膜開発について記す。無機分離膜は、分離層を 薄膜化するために、多孔質セラミック基材上に製膜される ことが多い。分離層にピンホールなどの欠陥がある場合は、 選択性が大きく低下するため,薄膜化と均質性の両立が重 要である。そこで、我々は対向拡散化学蒸着(CVD)法を 利用して膜開発を進めている。対向拡散 CVD 法では,多孔 質基材の両側より、シリカ源となる前駆体と酸素などの反 応助剤をそれぞれ別に供給する。多孔質基材の細孔の両側 より拡散する前駆体と反応助剤が細孔中で接触することで 蒸着反応が進行する。この反応でシリカ複合分離層が細孔 中に蒸着していく。蒸着したシリカ複合分離層により、前 駆体、反応助剤の拡散が抑制されて反応が止まり、均質な 薄膜が得られる。4) この時, 前駆体としてシリコンアルコ キシドを用いた場合は、シリカ薄膜が得られる。シリカは、

水素の分子サイズより、わずかに大きい約 0.3 nm 程度の細 孔をもつ。そのため、分子の大きさの違いによる分子ふる い機構により水素を選択的に透過する分離膜となる。分子 ふるい機構で、二酸化炭素など、様々な分子を分離する膜 を得るには、Aレベルで細孔径を制御する必要がある。そ こで、前駆体として、有機シリコンアルコキシド等、有機 物を含有するものを用いるアイディアが提案された。5) Fig.1 にシリカ複合膜の製膜イメージを示す。有機シリコン アルコキシドの有機置換基は Si-C 結合をもち, アルコキシ ドの蒸着反応時に安定である。そのため、蒸着時に有機物 が残存する。その後、残存した有機物の一部が分解するな どして、シリカ分離層と比較して細孔が大きくなる。この 時の重要な蒸着条件は,蒸着温度である。分離層に残存し た有機物が、熱分解や反応助剤の作用により一部分解し、 微細な細孔制御が可能となる。ここでは、シリカ複合膜の 蒸着状況と熱分解状況を調査し、細孔径の制御メカニズム について考察する。シリカ複合膜の分離層は 1 µm 以下の 厚みであり、その中に含有されている有機置換基は微量で あり、分析が困難である。このため、シリカ前駆体を加水 分解して作製したシリカ複合粉末上の有機置換基の熱・化 学的分解挙動について検討を行い、蒸着膜との関係を考察 した。



Fig.1 Schematic diagram for pore size control of the counter diffusion chemical vapor deposition method.

2. 対向拡散 CVD 法

シリカ複合膜は、 γ -アルミナ多孔質チューブ基材(外径 3.0 mm もしくは 10 mm, 孔径 150 nm)に製膜した。シリカ 前駆体として Table 1 に示すアルコキシド(信越化学製)を 用いた。対向拡散 CVD 法による製膜・気体透過試験装置の 概要図を Fig.2 に示す。前駆体は 45~175 ℃の金属容器 より 200 L min⁻¹の窒素バブリングで、チューブ基材の外側 に供給した。反応助剤としてオゾンもしくは酸素を 200 mL min⁻¹ でチューブ基材内部に導入した。蒸着は 150-600 ℃, 5-180 分で行った。

Table 1List of silicon precursors.

	abbreviation	substituent
Tetramethoxysilane	TMOS	—
Methyltrimethoxysilane	MTMOS	-CH ₃
Ethyltrimethoxysilane	ETMOS	-C2H5
n-Propyltrimethoxysilane	PrTMOS	-C3H7
Hexyltrimethoxysilane	HTMOS	-C ₆ H ₁₃
Decyltrimethoxysilane	DTMOS	-C10H21
Phenyltrimethoxysilane	PhTMOS	-C6H5
Dimethoxydiphenylsilane	DPhDMOS	$-C_6H_5 \times 2$
3-Aminopropyltriethoxysilane	APrTEOS	-C ₃ H ₆ NH ₂
3-Amino	APrM	C ₃ H ₆ NH ₂ ,
propyldiethoxymethylsilane	DEOS	-CH ₃



Fig.2 Schematic diagram of the CVD apparatus.

気体透過は、3 種類の無機ガスである水素(H2,0.28 nm), 窒素(N2,0.36 nm), 六フッ化硫黄(SF6,0.55 nm)を用いた 蒸着温度が270℃よりも低い膜の場合は、蒸着させた温度 と同温度で気体透過性能を評価した。蒸着温度が270℃よ り高い場合は、270℃にて透過試験を行った。これらのガ ス透過試験結果より、フィッティングにより細孔径を推算 している。

シリカ前駆体の加水分解粉末は、ゾルゲル法を用いて作 製した。前駆体に水酸ナトリウム水溶液、エタノール、水 を加え攪拌し、その後10℃で乾燥させた。この加水分解粉 末の熱分解挙動を熱重量測定装置(TG:TGA-50,島津製作 所)にて調査した。50 mL min⁻¹の窒素雰囲気下にて、600℃ まで5℃ min⁻¹で昇温し、重量減少を調査した。次に、酸 化雰囲気での有機置換基の熱分解挙動を評価するため、 CVD条件と同様のオゾン流量・温度・時間でシリカ源加水 分解粉末を処理し、オゾン処理前後のシリカ源加水分解粉 末中の有機置換基量の変化をフーリエ変換赤外吸収スペク トル(FT-IR)(FTIR-8400S,島津製作所製)で評価した。 FT-IR 測定は KBr 錠剤法を用いて行った。

3. シリカ前駆体と蒸着膜性能の関係

3.1 前駆体種とガス透過性

まず、シリカ前駆体として有機置換基を含有しない TMOS を用いて製膜を行った。水素/窒素透過率比が 200 を 超える膜が 88 %得られた。これより対向拡散 CVD 法によ る製膜の再現性は高いと言える。シリカ前駆体に導入した 有機置換基は、アルキル基、フェニル基、アミノプロピル 基に分類できる。Fig.3 に, Table 1 で示したシリカ前駆体 を用いて製膜した分離膜の透過特性をまとめる。シリカ膜 は水素選択透過膜となるので,縦軸に水素透過率を用いる。 横軸は、3 種のガスの透過率より評価した分離膜の細孔径 を示す。前駆体に TMOS を用いたもののみ 600 ℃蒸着であ り,他の膜はすべて270℃蒸着である。水素分子の分子径 は 0.28 nm なので、細孔径が 0.3 nm 程度であれば水素のみ を選択的に透過する。ここで、二酸化炭素の分子径が 0.33 nm, プロピレンが 0.36 nm, ベンゼンが 0.60 nm なので, 重 要なガス分離用の膜の開発には、0.3~0.6 nm のレベルで、 微細に細孔径が制御できることが重要である。前駆体がす べてアルコキシドで構成されている TMOS を原料蒸気とし た場合に得られた膜の細孔径が0.37 nmと最も小さかった。 置換基がなく純粋なシリカ膜が得られたため細孔が小さ かった。水素透過率は 10^{-7} mol m⁻² s⁻¹ Pa⁻¹ レベルであり、 水素選択分離膜として十分に高い値である。

置換基としてアルキル基をもつ ETMOS, PrTMOS, HTMOS を用いて製膜した膜の細孔径は, 0.38~0.41 nm と TMOS を原料とした分離膜よりわずかに大きくなっている。



Fig.3 H₂ permeance through the deposited membranes by changing the silica precursors plotted as a function of pore sizes. Deposition temperature: $270 \text{ }^{\circ}\text{C}$ without TMOS (600 $^{\circ}\text{C}$).

0.01 nm レベルと非常に微細なレベルの細孔径制御が可能 であることが示された。水素透過率は、TMOS を原料とし た分離膜の 2.5 倍~4 倍と非常に大きくなっている。細孔 径の増大は、膜中の拡散抵抗の減少につながり、透過性も 向上したことがわかる。置換基のサイズが大きなフェニル 基をもつ前駆体である PhTMOS, DPhDMOS を用いた場合 は細孔径がそれぞれ 0.53 nm, 0.61 nm と非常に大きくなっ た。フェニル基を一つもつ PhTMOS と比較して二つもつ DPhDMOS を原料とした場合の方が大きな細孔の膜が得ら れている。導入する置換基のサイズだけでなく置換基の個 数も細孔径に影響を与えることがわかる。水素透過率はア ルキル基を導入した前駆体の場合と同レベルである。ある 程度細孔径が大きくなると、細孔径増大が透過性に及ぼす 影響が小さくなる。アミノプロピル基を導入した APrTEOS と APrMDEOS の場合は、この2種で得られた膜の性質は 大きく異なっていた。APrTEOS は、PrTMOS のプロピル基 の末端の水素がアミノ基(NH2)に置き換わったものであ る。そのため、上で記した PrTMOS を用いた膜と比較して 得られた膜の細孔径は大きい。水素と比較してアミノ基の サイズが大きいためである。一方, APrMDEOS は APrTEOS のアルコキシドがメチル基に置き換わったものである。 APrMDEOS を用いたものは細孔径が最も大きい反面, 水素 透過率はそれほど大きくない。APrMDEOS を原料した場合 は, 蒸着反応が抑制されるなど, 置換基のサイズの影響以 外の原因を考察する必要がある。以上,270℃蒸着におい ては、大まかには前駆体の置換基サイズの増大に伴い得ら れる膜の細孔径が微細に制御できることがわかった。以下, 各種前駆体について蒸着温度の影響を、同じ前駆体より作 製した加水分解粉末上の置換基分解挙動と共に考察する。

3.2 アルキル基導入前駆体について

Fig.4 に、有機置換基として 3 つの炭素より構成される プロピル基をもつ PrTMOS を用いて製膜した分離膜の細孔 径の蒸着温度依存性を示す。同じ図中に加水分解粉末の FT-IR 測定結果および TG 分解挙動を示す。上から順に分離 膜の細孔径, IR 測定におけるアルキル基起因の 2960 cm⁻¹ のオゾン処理前後の比率, TG 測定における重量変化であ る。PrTMOS 膜の細孔径は、低温である 180 ℃で蒸着させ た膜は 0.66 nm, 中温である 240~360 ℃で蒸着させた膜は 0.49±0.03 nm, 高温である 400 ℃で蒸着させた膜は 0.58 nm と3つに分類できる。TG結果より, 300~400 ℃で重量減 少が確認できることから、プロピル基はこの温度域で分解 し,400 ℃以上では残存していないといえる。FT-IR 結果よ り,200 ℃以下の吸光度比は,200~300 ℃でオゾン処理し た加水分解粉末よりも吸光度比が 0.2 と低いことから、熱 分解ではなくオゾンの影響でプロピル基が分解したといえ る。以上から、200 ℃以下で蒸着させた膜の細孔径が大き い理由は、オゾンによりプロピル基が分解されたためとい える。一方,400℃以上では、熱分解の影響でプロピル基が 分解し、大きな細孔径の膜が得られた。

Fig.5 に,6 つの炭素より構成されるヘキシル基をもつ HTMOS の結果を示す。プロピル基の結果と同様に,細孔 径,FT-IR,TG の結果を上から順にまとめる。PrTMOS 膜 と同様に細孔径の大きさは蒸着温度で3 段階に分類できる。 区分1は180 ℃で蒸着させた膜,区分2は270 ℃から450 ℃ で蒸着させた膜,区分3 は 500 ℃で蒸着させた膜である。 1 つ目と3 つ目の細孔径が 0.76±0.01 nm と大きい膜が得ら れた理由は,前述の PrTMOS 膜と同様であると考えらえる。

TG 測定より, ヘキシル基の分解温度域は 350℃から 480℃であり, プロピル基よりも耐熱性が高いことが示唆さ れた。また FT-IR より, ヘキシル基のオゾン分解はプロピ



Fig.4 (a) Pore sizes through the PrTMOS derived membranes by changing the deposition temperature. (b) FT-IR absorbance ratio of PrTMOS hydrated powder after O₃ treatment. (c) TG measurement of PrTMOS hydrated powder under N_2 .



Fig.5 (a) Pore sizes through the HTMOS derived membranes by changing the deposition temperature. (b) FT-IR absorbance ratio of HTMOS hydrated powder after O_3 treatment. (c) TG measurement of HTMOS hydrated powder under N_2 .

ル基より大きいアルキル基の炭素数が大きくなって分解が 容易になったためである。

PrTMOS 膜と HTMOS 膜の細孔径を比較すると, 区分 1, 2,3 のいずれも HTMOS 膜の細孔径の方が PrTMOS 膜より も大きかった。ここで Fig.6 に MTMOS, ETMOS, DTMOS 加水分解粉末の TG 結果を示す。各シリカ源加水分解粉末 の分解温度域に焦点を当てると,メチル基,エチル基,デ シル基をもつシリカ源で分解温度域は、それぞれ 500-580 ℃,320-500 ℃,450-480 ℃であった。このようにアル キル基の長さが変わることで,熱分解温度域が変わること がわかった。



Fig.6 TG measurement of MTMOS, ETMOS and DTMOS hydrated powder under N₂.

3.3 フェニル基導入前駆体について

次にフェニル基をもつシリカ複合膜について、細孔径と フェニル基の熱分解挙動を調査した。Fig.7 に PhTMOS を 原料として得られた膜の細孔径とフェニル基の残存量の温 度依存性を示す。図は上より、分離膜の細孔径、IR 測定に おけるフェニル基起因の 1431 cm⁻¹のオゾン処理前後の比 率、TG 測定における重量変化である。PhTMOS 膜の細孔 径は、蒸着温度 300 ℃以下の膜は約 0.6 nm, 蒸着温度が 300 ℃より高い膜は約 0.9 nm であった。熱分解時に、フェ ニル基由来の質量分析ピーク (m/z = 78) を確認した。TG 測定結果より、フェニル基は 2 段階で分解していることが 分かった。300 ℃以上で分解量が増加し、その後 450 ℃以 降はフェニル基が検出されなかったため、全てのフェニル 基が分解したといえる。PhTMOS 膜の細孔径が蒸着温度 300 ℃前後で大きく変化しているのは、フェニル基の分解 量の増加に由来する。

Fig.8 に DPhDMOS 膜の細孔径とフェニル基の残存量の 温度依存性を示す。シリカ源の構造中にフェニル基を2つ もつ DPhDMOS 膜の細孔径は、最大細孔径が1.13 nm、最 小細孔径が0.6 nm であった。前駆体中にフェニル基を2つ もつが、得られた膜の細孔径分布は小さく、図中に示した 値であった。最小細孔径はPhTMOS 膜と同程度であった。 TG 結果より、フェニル基の分解量は300 ℃以上で増加し、 PhTMOS、DPhDMOS ともに同じであることが分かった。 フェニル基の分解量の少ない240 ℃で蒸着させた DPhDMOS 膜は、細孔径が0.87 nm であり、240 ℃蒸着させ た PhTMOS 膜の細孔径の1.8 倍大きかった。シリカ源中に 含まれるフェニル基の量が DPhDMOS は PhTMOS の2 倍 であるため、大きな細孔径が形成されやすい可能性がある。



Fig.7 (a) Pore sizes through the PhTMOS derived membranes by changing the deposition temperature, (b) FT-IR absorbance ratio of PhTMOS hydrated powder after O₃ treatment. (c) TG measurement of PhTMOS hydrated powder under N_2 .



Fig.8 (a) Pore sizes through the DPhDMOS derived membranes by changing the deposition temperature. (b) FT-IR absorbance ratio of DPhDMOS hydrated powder after O₃ treatment. (c) TG measurement of DPhDMOS hydrated powder under N₂.

4. おわりに

対向拡散 CVD 法により、多孔質セラミック基材上にシ リカ複合膜を作製した。シリカ前駆体としてシリコンアル コキシドを用い、アルコキシド基をアルキル基など有機置 換基に置き換えることで、蒸着膜の細孔径を微細に制御で きることを明らかにした。有機置換基を導入しない場合の 細孔径は0.37nmと水素を選択的に透過する膜が得られた。 置換基としてプロピル基を導入した場合の細孔径は, 0.40 nm と 0.03 nm 細孔径が大きくなった。非常に微細なレベル の細孔径制御が可能である。さらに、水素透過率も 3.7 倍 と大きくなった。細孔径制御により、膜中の拡散抵抗を減 少させ、透過性も向上できる。置換基のサイズが大きなフ ェニル基をもつ前駆体である PhTMOS を用いた場合の細 孔径は 0.53 nm であった。細孔径は導入する置換基サイズ と対応した。この様な蒸着現象を、シリカ加水粉末上の有 機置換基の熱分解挙動を調査することで考察した。有機置 換基の分解温度は,有機置換基の種類で変化するが,分解・ 蒸着挙動は低温、中温、高温で変化することがわかった。 200 ℃程度の低温ではオゾンによる有機置換基の分解が観 察された。一方, 250 ℃程度の中温では, 反応助剤であるオ ゾンの分解も進み、有機置換基の分解は限定的であった。 400 ℃以上の高温では、有機置換基の熱分解が支配的であ り、分離膜中の有機物は少なくなっていると推測される。 そのため、低温、高温蒸着では、得られる膜の細孔径が 小さくなり、中温蒸着において大きな細孔径が得られる傾 向を見出した。この様なシリカ複合膜の細孔径制御技術を ベースに、二酸化炭素分離、炭化水素分離など大きな分離 マーケットに適用できる分離膜の開発を進めていきたい。

文 献

- 1) M. Kanezashi, et al., Ind. Eng. Chem. Res. 51, 944-953 (2012).
- M. Tsapatsis and G. R. Gavalas, J. Membr. Sci. 87, 281–296 (1994).
- 3) J. Hayashi, et al., Ind. Eng. Chem. Res. 35, 4176-4181 (1996).
- 4) M. Nomura, et al., J. Membr. Sci. 251, 151-158 (2005).
- 5) M. Nomura, et al., J. Chem. Eng. Jpn. 40, 1235-1241 (2007).



野村 幹弘 Mikihiro Nomura E-mail: Lscathy@shibaura-it.ac.jp